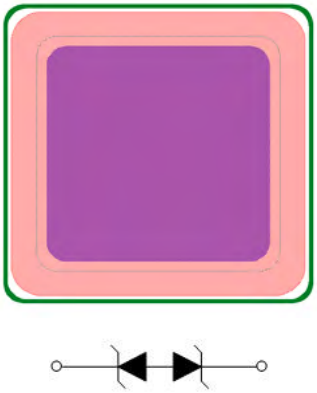
# LM606ESDCP25-0.4

## 概述

- LM606ESDCP25-0.4 是利用先进的硅电路工艺生产的双向普通电容静电放电保护器件；
- 低钳位电压；
- 快速的响应速度；
- 低漏电电流（<100nA）；

  IEC6100-4-2(ESD)：+/-30KV(空气放电)；+/-30KV(接触放电)



## 芯片信息

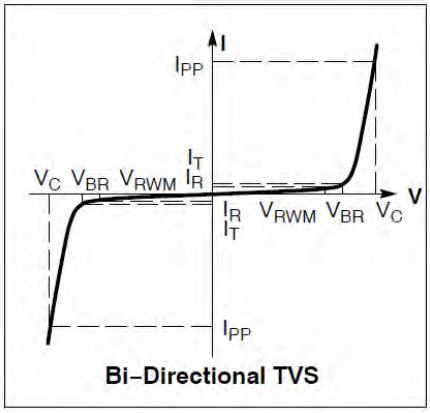
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 流片代码 | KID047 |
| 圆片尺寸 | 6Inch |
| 有效管芯数 | 98000dies |
| 芯片尺寸 | 400μm×400μm |
| 压点尺寸 | 340μm×340μm |
| 芯片厚度 | 150±10μm/厚片 |
| 正面金属 | Al:3μm |
| 背面金属 | Ti/Ni/Ag 或 Ti/Ni/Sn/Ag |
| 划片道宽度 | 50μm |

## 极限参数（Tamp=25℃）

| 参　　数 | 符 号 | 额定值 | 单 位 |
|---|---|---|---|
| 芯片最高工作温度范围 | Topr | -55 ~ +125 | ℃ |
| 芯片最高存储温度范围 | Tstg | -55 ~ +150 | ℃ |

## 电性参数（Tamp=25℃）

| Symbol | Parameter |
|---|---|
| $I_{PP}$ | Maximum Reverse Peak Pulse Current |
| $V_C$ | Clamping Voltage @ $I_{PP}$ |
| $V_{RWM}$ | Working Peak Reverse Voltage |
| $I_R$ | Maximum Reverse Leakage Current @ $V_{RWM}$ |
| $V_{BR}$ | Breakdown Voltage @ $I_T$ |
| $I_T$ | Test Current |
| $P_{pk}$ | Peak Power Dissipation |
| C | Capacitance @ $V_R$ = 0 and f = 1.0 MHz |




| Item | Symbol | Test Conditions | Criterion | | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min | Typ | Max | |
| 最大峰值功率 | $P_{PK}$ | $I_{PP}$=25A,$t_p$=8/20μs | | | 315 | W |
| 维持电压 | $V_{RWM}$ | | | | 6 | V |
| 击穿电压 | $V_{BR}$ | $I_T$=1mA | 6.5 | | 8 | V |
| 漏电流 | $I_R$ | $V_{RWM}$=±6.0V | | | 0.1 | μA |
| 钳位电压 | $V_C$ | $I_{PP}$ =5A,$t_p$=8/20μs | | | 9.5 | V |
| 钳位电压 | $V_C$ | $I_{PP}$ =25A,$t_p$=8/20μs | | 12.5 | 13 | V |
| 电容 | $C_j$ | $V_R$=0V,f=1MHz | | 100 | 110 | pF |

注意事项：

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 25±5℃，湿度≤45%；
- 封装时，请将距离圆片边沿 4mm 及以内位置的管芯剔除；

NOTICE

Leiditech reserves the right to make modifications,enhancements,improvements,corrections or other changes without further notice to any product herein. Leiditech does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein.

Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd.
Email: sale1@leiditech.com
Tel : +86- 021 50828806
Fax : +86- 021 50477059